



2015年10月27日

名古屋大学への当社製 MOCVD 装置納入について

大陽日酸株式会社（社長 兼 CEO：市原 裕史郎）は、2014 年にノーベル物理学賞を受賞した国立大学法人名古屋大学天野浩教授の研究室に研究開発用 MOCVD 装置他、周辺設備を納入する事が決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 背景

名古屋大学では、本年 10 月 1 日に窒化物半導体の研究拠点を開設し、結晶成長だけでなく、デバイス作製・評価までを一貫して手掛け、窒化物半導体の持つポテンシャルを最大限に引き出す研究開発が予定されています。

大陽日酸が、国際入札によって納入することが決定した MOCVD 装置で、青色発光ダイオード(LED)を開発した際に使われた窒化ガリウムを応用し、大幅に電力損失を抑え省エネルギーにつながる次世代パワー半導体の研究が進むものと期待しています。

大陽日酸では当社の装置を使った同大学の研究を通じて、省エネルギー社会実現に貢献するとともに、当社製 MOCVD 装置の優位性をさらに高めてまいります。

2. 納入する装置の概要

- ・ MOCVD 装置

処理能力： 最大 4 インチ径 3 枚

型 式： S R 8 0 0 0

特 徴： バルク GaN(窒化ガリウム)基板上への高耐圧トランジスタやダイオードの研究に必要な厚膜成長のニーズに応える高純度・高速成長 MOCVD

- ・ HVPE (Hydride Vapor Phase Epitaxy：ハイドライド気相成長) 装置

処理能力： 2 インチ 1 枚

型 式： H V P E 3 0 0

特 徴： 次世代 GaN 基板開発用装置。最高成膜温度 1500℃。

- ・ その他ガス供給関連設備

窒素用高純度ガス精製装置、水素用高純度ガス精製装置

シリンダーキャビネット 4 台

燃焼式排ガス処理装置

3. 納入時期

2016 年 1 月予定

以 上

本件に関するお問い合わせ

大陽日酸株式会社

東京都品川区小山 1-3-26 東洋 Bldg.

国際・経営企画本部広報・I R 部 鎌田・田代

TEL:03-5788-8015